

VERSUCHSBERICHT ZU

MP1 - EIGENSCHAFTEN DER
SOLARZELLE

Gruppe BA-C-04

Alexander Neuwirth (E-Mail: a_neuw01@wwu.de)
Leonhard Segger (E-Mail: l_segg03@uni-muenster.de)

durchgeführt am 21.01.2019
betreut von
Finn Kutschmann

10. Februar 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Kurzfassung	3
2	Theorie	3
2.1	Halbleiter	3
2.1.1	pn-Übergang	3
2.2	Solarzelle	4
2.2.1	Vierspitzenmethode	5
3	Methoden	5
3.1	Solarzellen	5
3.2	Dotierstoffe	6
4	Ergebnisse und Diskussion	6
4.1	Dotierstoffe	6
4.1.1	Unsicherheiten	6
4.1.2	Beobachtung und Datenanalyse	6
4.1.3	Diskussion	9
4.2	Solarzelle	9
4.2.1	Unsicherheiten	9
4.2.2	Beobachtung und Datenanalyse	9
4.2.3	Diskussion	12
5	Schlussfolgerung	12
6	Anhang	12
6.1	Solarzelle	12

1 Kurzfassung

Es wird erwartet, dass die Angaben auf dem den Proben beiliegenden Zettel bezüglich des Vorhandenseins einer Dotierung bestätigt werden können. Nicht möglich war es die Art der Dotierung zu bestimmen, da diese Funktion des Vierspitzenmessgeräts nicht mehr funktionierte.

2 Theorie

2.1 Halbleiter

Um die Solarzelle verstehen zu können, muss man zunächst dotierte Halbleiter und die Diode verstehen. Halbleiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu Leitern eine Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband besitzen, welche gleichzeitig im Vergleich zu Isolatoren sehr gering ist. Im folgenden werden elementare Halbleiter der vierten Hauptgruppe betrachtet, aber die Erklärungen lassen sich auch auf andere Halbleiter ausweiten. Andere Halbleiter sind beispielsweise aus Elementen der dritten und fünften Hauptgruppe zusammengesetzt. Das prominenteste Beispiel hierfür ist Galliumarsenid.

Bei Raumtemperatur befinden sich in Halbleitern nur wenige Ladungsträger im Leitungsband, weshalb der spezifische Widerstand groß ist. Wenn nun Elemente aus der fünften Hauptgruppe (Donatoren) in das Gitter eingebracht werden, nennt man das n-Dotierung, da die eingebrachten Elemente ein Elektron zu viel in der äußeren Schale haben, um sich optimal in das Gitter einfügen zu können. Das führt dazu, dass dieses Elektron nicht fest am Atomrumpf sitzt, sondern durch thermische Anregung leicht ins Leitungsband befördert werden kann und somit der spezifische Widerstand sinkt bzw. die Leitfähigkeit steigt. Analog kann mit Elementen aus der dritten Hauptgruppe (Akzeptoren) dotiert werden. Dies führt zu fehlenden Elektronen im Gitter, sodass mit einer geringen thermischen Anregung ein Elektron von einem benachbarten Atom in die Fehlstelle springen kann. Jetzt liegt die Fehlstelle an dem anderen Atom, zu dem wiederum ein anderes Elektron springen kann. Das Loch ist also beweglich und erlaubt einen Ladungstransport, weshalb auch hier der Widerstand sinkt.

2.1.1 pn-Übergang

Wenn man einen p-dotierten Halbleiter in direkten Kontakt mit einem n-dotierten bringt oder einfach einen Halbleiter an zwei Seiten unterschiedlich dotiert, nennt man dies einen pn-Übergang.

Aus energetischen Gründen wandern dann Elektronen und Löcher aufeinander zu und rekombinieren in der Übergangszone. Da hierbei jedoch im n-dotierten Halbleiter Atome mit einem Elektron weniger zurückgelassen werden, als sie Protonen im Kern haben, beginnt sich auf dieser Seite des Halbleiters eine positive Gesamtladung zu sammeln. Gleichzeitig erhalten die Atome im p-dotierten Halbleiter ein Elektron mehr, als sie Protonen im Kern haben, sodass sich hier eine negative Gesamtladung sammelt.

Das elektrische Feld, das durch die Ladungsdifferenz entsteht wirkt energetisch der Rekombination entgegen, sodass sich ein Gleichgewicht mit einer Raumladungszone zwischen den Halbleitern einstellt. Diese Raumladungszone sorgt für die vielfältigen Eigenschaften des pn-Übergangs, der auch Diode genannt wird: Wird eine Spannung so angelegt, dass der Pluspol am p-dotierten Halbleiter liegt, baut diese die Raumladungszone ab und es kommt zu einem exponentiellen Anstieg der Stromstärke. Wird die Spannung andersherum angelegt, wird die Raumladungszone verbreitert und die Diode sperrt, sodass der Stromfluss gering (Null) ist.

Die Diode wird charakterisiert durch die Diodenkennlinie, die die Abhängigkeit vom Stromfluss zur angelegten Spannung angibt und idealerweise der folgenden Gleichung gehorcht:

$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{eU}{nk_B T} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

In realen Dioden (besonders Solarzellen) treten jedoch ohmsche Verluste auf, was die Beschreibung durch eine ideale Diode, die mit einem Widerstand in Reihe (R_{sh}) und einem anderen parallel (R_s) geschaltet wurde, erforderlich macht. Dadurch wird Gleichung (1) folgendermaßen modifiziert:

$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{e(U - IR_s)}{nk_B T} \right) - 1 \right] + \frac{U - IR_s}{R_{sh}} \quad (2)$$

2.2 Solarzelle

In der Solarzelle wird ein pn-Übergang verwendet, der so offengelegt wird, dass das Licht auf ihn fallen kann. Wenn dies der Fall ist, geben die Photonen den Elektronen im Halbleiter die nötige Energie, um die Elektronen aus dem Gitter zu lösen, sodass ein Elektron-Loch-Paar entsteht. Wenn dieses Paar in die Raumladungszone diffundiert, bevor es rekombiniert, wird es dort durch das elektrische Feld getrennt. Wenn die beiden Enden des pn-Übergangs jetzt über einen Widerstand (oder einen anderen Verbraucher) leitend verbunden werden, können die von den Löchern getrennten Elektronen über den Widerstand rekombinieren, an dem dementsprechend ein Strom gemessen werden kann. Dieser Photostrom fließt in Sperrrichtung und modifiziert die ideale Diodengleichung wie folgt:

$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{eU}{nk_B T} \right) - 1 \right] - I_{ph} \quad (3)$$

In Abb. 1 ist dargestellt, wie dieser Vorang im Banschema aussieht und wie die durch den Photostrom modifizierte Diodenkennlinie aussieht. Wenn ein Photodetektor gebaut werden sollte, der einen linearen Zusammenhang zwischen Stromfluss und einfallenden Photonen herstellen soll, würde eine Spannung angelegt werden und der dritte Quadrant wäre relevant. Da jedoch eine möglichst hohe Leistung erzielt werden soll, wird bei der Solarzelle der vierte Quadrant verwendet. Die Spannung entsteht hier aufgrund des Stromflusses und muss nicht extern angelegt werden. Wenn der Widerstand des Widerstands, über den die Enden des Halbleiters verbunden sind, verschwindet stellt sich

der sog. Kurzschlussstrom $I_{sc} = -I_{ph}$ ein. Wenn andersherum keine Verbindung besteht (unendlich großer Widerstand) stellt sich die Leerlaufspannung U_{oc} ein. Für die Anwendung soll im Allgemeinen die Leistung maximiert werden, weshalb der sog. Maximum Power Point (MPP) gesucht wird, welcher sich bei der Leistung

$$P_{max} = I_{sc} \cdot U_{oc} \cdot FF \quad (4)$$

ergibt. FF ist dabei der Füllfaktor, der von der Bauart der Solarzelle abhängt.

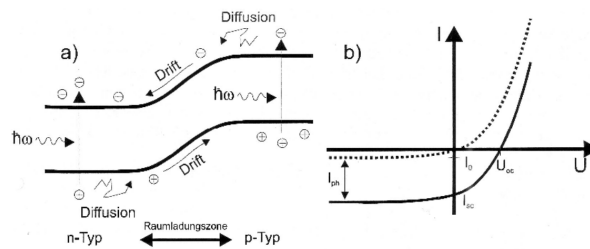


Abbildung 1: a) pn-Übergang unter Beleuchtung: Die photogenerierten Minoritätsladungsträger diffundieren zunächst zur Raumladungszone und werden dort durch das elektrische Feld getrennt b) Strom-Spannungs-Charakteristik einer Solarzelle. Die Kennlinie ergibt sich aus der Summe von Diodenstrom I und Photostrom I_{ph} (negatives Vorzeichen!). [**anleitung**]

2.2.1 Vierspitzenmethode

Die Vierspitzenmethode ermöglicht die Messung des Flächenwiderstands in einer dünnen Probe. Dazu werden vier Spitzen, die sich unter gleichem Abstand in einer Linie befinden, auf die Probenoberfläche gedrückt. Über die äußeren beiden lässt das Gerät dann einen bekannten Strom fließen und misst die Potenzialdifferenz zwischen den mittleren beiden. Die Vierspitzenmethode basiert auf dem Prinzip der Vierletermessung nach Thomson und Kelvin, die es erlaubt den untersuchten Widerstand unabhängig vom Anschlusswiderstand (hier dem Übergangswiderstand Spitze zu Probe) zu bestimmen.

3 Methoden

3.1 Solarzellen

Da der vorliegende Versuchsaufbau fehlerhaft war und es nicht möglich war die Messungen zur Solarzelle durchzuführen, wird hier nur das grundsätzliche Vorgehen beschrieben.

Es sollen für eine Tandemsolarzelle und eine Solarzelle aus polykristallinem Silizium I-U-Kennlinien aufgenommen werden. Dies wird ohne Beleuchtung der Solarzellen, bei vollständigem Sonnenspektrum und bei einem AM-gefilterten Sonnenspektrum bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Dazu wird an die Zellen eine Spannung angelegt, die schrittweise erhöht wird. Bei Beleuchtung könnte auch der Lastwiderstand variiert werden, um die I-U-Kennlinie aufzunehmen. Dies würde jedoch das Messen negativer

Spannungen unmöglich machen, die so in die Fit-Funktion mit einbezogen werden können.

3.2 Dotierstoffe

Es wird ein Gerät verwendet, dass die Vierspitzenmethode verwendet, um den spezifischen Widerstand der zu untersuchenden Halbleiter zu bestimmen. Dazu werden jeweils zehn Messungen des Oberflächenwiderstands durchgeführt und dann fünf mal mit einem digitalen Mikrometer die Dicke der Probe gemessen, um wissen zu können, ob ein Korrekturfaktor bei der Bestimmung des Widerstands nötig ist. Untersucht werden unterschiedlich dotierte Silizium- und Germaniumproben. Den Proben liegt ein Zettel bei, der angibt, ob sie p- oder n-dotiert oder intrinsisch sind.

Zusätzlich wird eine Silizium-Scheibe untersucht, die vollständig mit Phosphor dotiert und dann von beiden Seiten mit Gallium dotiert wurde. Dadurch ergibt sich eine tiefenabhängige Dotierung, die untersucht werden soll, indem schrittweise Schichten abgetragen werden und jeweils wie oben die Dicke und der Flächenwiderstand gemessen.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Dotierstoffe

4.1.1 Unsicherheiten

4.1.2 Beobachtung und Datenanalyse

Dotierungskonzentrationen

Mit der Vierspitzenmethode wurde der Widerstand $R = U/I$ gemessen. Daraus lässt sich dann mittels der Scheibendicke d für dünne Scheiben ($d/s < 0.5$, $s = 1,59$ mm Messspitzenabstand):

$$\rho = \frac{Rd\pi}{\ln 2} \cdot F(d/s) \quad (5)$$

$$u(\rho) = \rho \cdot \sqrt{(u(R)/R)^2 + (u(d)/d)^2} \quad (6)$$

Für die dickere Scheiben erhält man einen Korrekturfaktor $F(d/s)$ ungleich 1 gemäß der DIN-NORM. Dieser beträgt für Probe 4 $F = 0.84$ und für Probe 5 $F = 0.83$.

In Tabelle 1 befinden sich die gemittelten Messergebnisse.

Tabelle 1

Nr.	Mat.	dot.	Widerstand R in Ω	Scheibendicke d in mm	spez. Widerstand ρ in Ωcm
1	Si	p	50 ± 4	$0,4486 \pm 0,0009$	$10,1 \pm 0,7$
2	Si	n	$8,52 \pm 0,21$	$0,4532 \pm 0,0009$	$1,75 \pm 0,04$
3	Si	n	$0,0713 \pm 0,0018$	$0,0677 \pm 0,0010$	$0,0219 \pm 0,0005$
4	Si	p	$0,00192 \pm 0,00004$	$1,999 \pm 0,005$	$0,00146 \pm 0,00003$
5	Ge	i	25 ± 5	$2,1070 \pm 0,0013$	$19,92 \pm 3,32$
6	Si	n	$0,084 \pm 0,007$	$0,6826 \pm 0,0009$	$0,0260 \pm 0,0022$

Die Ladungsträgerkonzentrationen lassen sich mittels

$$\frac{1}{\rho} = en\mu_n + ep\mu_p \quad (7)$$

bestimmen. Für kristallines Silizium bei $T = 300\text{ K}$ gilt $c = n \cdot p = 2,1 \cdot 10^{19}\text{ cm}^{-6}$ und die Beweglichkeiten sind nach Tabelle 2 gegeben.

Tabelle 2: Beweglichkeitsdaten für Silizium und Germanium bei $T = 300\text{ K}$.

	μ_n in $\text{cm}^2/\text{V/s}$	μ_p in $\text{cm}^2/\text{V/s}$
Si	1350	480
Ge	3900	1900

Es ergibt sich:

$$n = \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2e\mu_n\rho}\right)^2 - c\mu_p/\mu_n} + \frac{1}{2e\mu_n\rho} \quad (8)$$

bzw.

$$p = \frac{c}{n} = \mp \sqrt{\left(\frac{1}{2e\mu_p\rho}\right)^2 - c\mu_n/\mu_p} + \frac{1}{2e\mu_p\rho} \quad (9)$$

Aus der Anleitung sind typische Größenordnungen für n/p-Dotierungskonzentrationen gegeben, woraus folgt, dass für n-dotierte das Vorzeichen vor der Wurzel in Gleichung (8) positiv und für p-dotierte negativ ist.

Für die intrinsische Ge-Probe gilt $n_i = n = p$. Also:

$$n_i = \frac{1}{\rho e(\mu_n + \mu_p)} \quad (10)$$

Tabelle 3: Dotierungskonzentrationen

Nr.	n in cm ⁻³	p in cm ⁻³	DIN in cm ⁻³
1	$(1,63 \pm 0,12) \cdot 10^4$	$(1,29 \pm 0,09) \cdot 10^{15}$	$p = 1,33 \cdot 10^{14}$
2	$(2,64 \pm 0,07) \cdot 10^{15}$	$(7,95 \pm 0,20) \cdot 10^3$	$n = 2,77 \cdot 10^{15}$
3	$(2,11 \pm 0,05) \cdot 10^{17}$	$99,3 \pm 2,5$	$n = 1,09 \cdot 10^{18}$
4	$2,36 \pm 0,05$	$(8,90 \pm 0,20) \cdot 10^{18}$	$p = 7,68 \cdot 10^{19}$
5	$(5,5 \pm 1,0) \cdot 10^{13}$	$(5,5 \pm 1,0) \cdot 10^{13}$	
6	$(1,78 \pm 0,15) \cdot 10^{17}$	118 ± 10	$n = 7,94 \cdot 10^{17}$

In Abb. 2 ist die Widerstandsmessung der phosphordotierten Si-Scheibe mit Ga-Diffusion gegen den Schichtenabtrag abgebildet. Der Widerstand erreicht ein Maximum bei $(65 \pm 2) \mu\text{m}$.

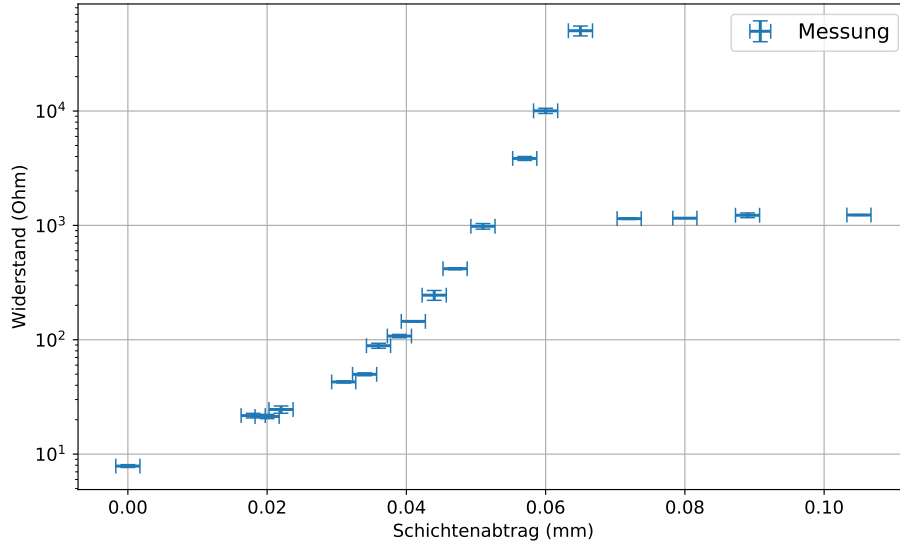


Abbildung 2

Der spezifische Widerstand ergibt sich aus

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{\ln 2}{\pi} \frac{dR^{-1}}{dx}, \quad (11)$$

bzw. numerisch

$$\frac{1}{\rho_i} = -\frac{\ln 2}{\pi} \frac{R_{i+1}^{-1} - R_i^{-1}}{x_{i+1} - x_i} \quad (12)$$

Man erhält durch Einsetzen in Gleichung (9) die Löcherkonzentration. Diese ist in Abhängigkeit vom Schichtenabtrag in Abb. 3 dargestellt.

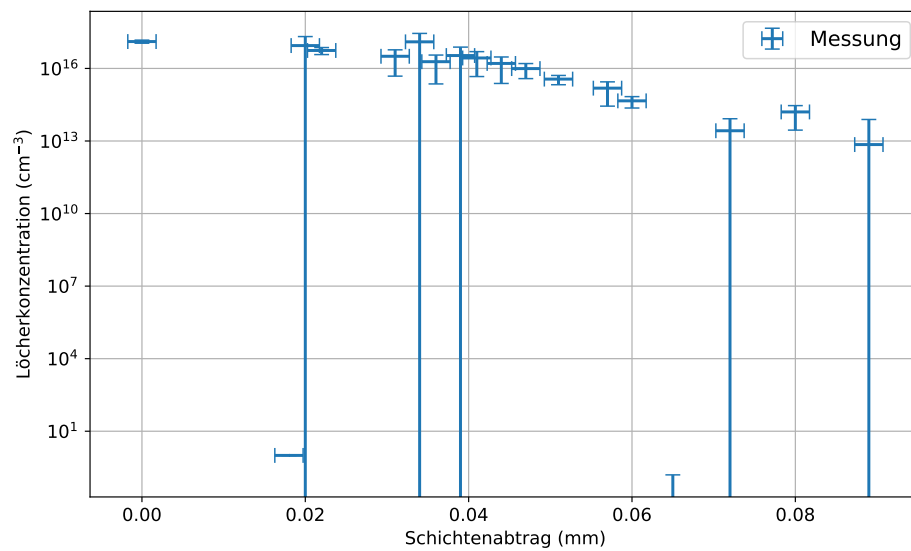


Abbildung 3

4.1.3 Diskussion

4.2 Solarzelle

4.2.1 Unsicherheiten

4.2.2 Beobachtung und Datenanalyse

Da keine eigenen Messungen zu den Solarzellen durchgeführt werden konnten, werden im folgenden alte Messdaten, die uns freundlicherweise von Finn Kutschmann ausgehändigt wurden, ausgewertet.

In Abb. 4 und Abb. 5 sind die aufgenommenen I-U-Kennlinien der polykristallinen Silizium Solarzelle und der Tandemzelle abgebildet.

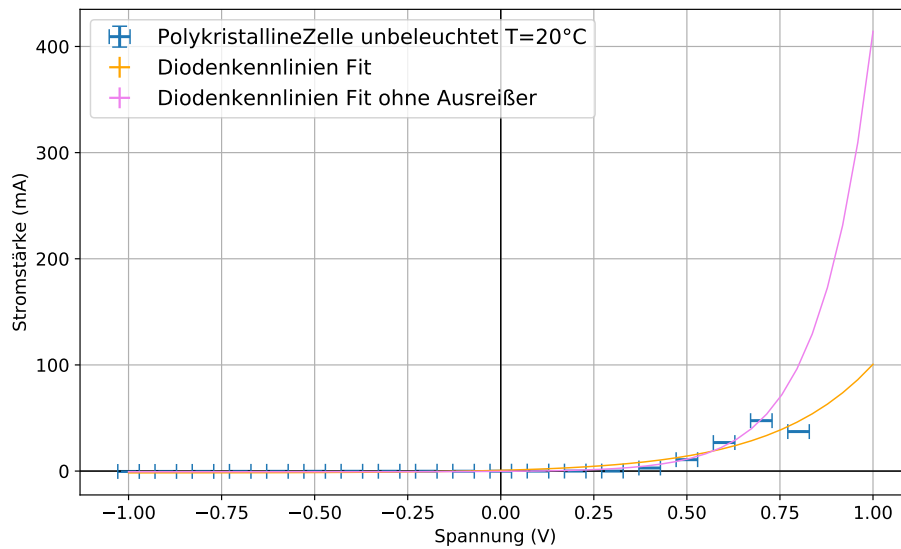


Abbildung 4: I-U-Kennlinie einer polykristallinen Silizium Solarzelle bei Raumtemperatur. Der Diodenkennlinien Fit ist deutlich schöner unter Vernachlässigung des Messwerts bei $U = 0,8 \text{ V}$.

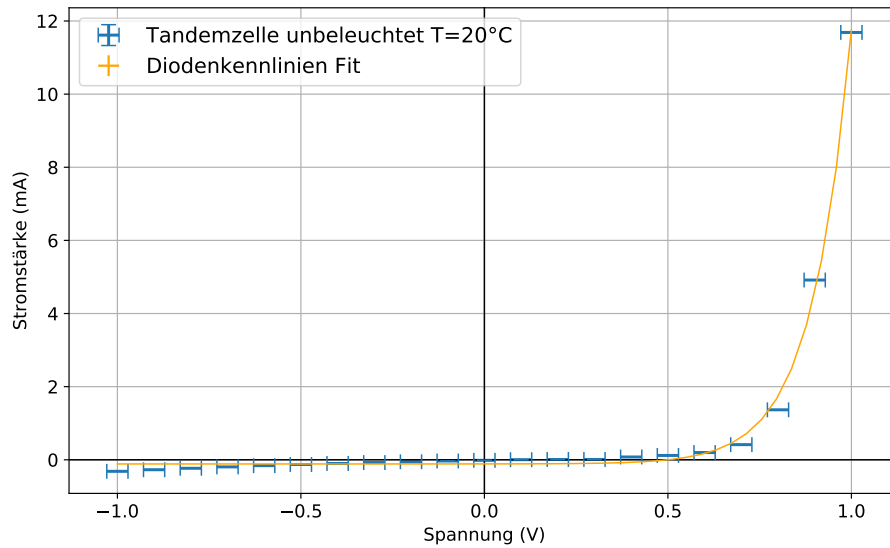


Abbildung 5: I-U-Kennlinie einer Tandemzelle bei Raumtemperatur.

Die Fitfunktion ist die ideale Diodenkennlinie unter Einstrahlung von Licht Gleichung (3).

Abb. 6 stellt exemplarisch die I-U-Kennlinie der Solarzellen dar, wenn sie mit Licht bestrahlt werden (weitere befinden sich im Anhang). Das rote (grüne) Rechteck gibt die im 4. Quadranten durch U_{MPP} und I_{MPP} (U_{oc} und I_{sc}) begrenzte Fläche an. Die rote Fläche entspricht der Maximalen Leistung $P_{max} = U_{MPP}I_{MPP}$. Der Füllfaktor FF ergibt sich als das Verhältnis der Flächen, also

$$FF = \frac{U_{MPP}I}{U_{oc}I_{sc}}. \quad (13)$$

Dabei konnten U_{MPP} , I und I_{sc} direkt aus den Messpunkten extrahiert werden. U_{oc} musste mittels des Fits interpoliert werden.

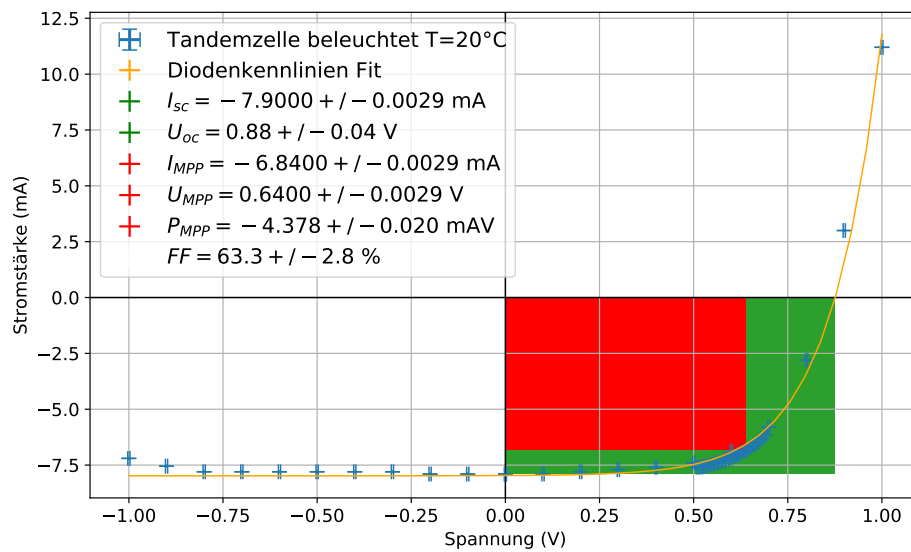


Abbildung 6: I-U-Kennlinie einer Tandemzelle bei $T = 20\text{ °C}$ unter Beleuchtung.

In Tabelle 4 und Tabelle 5 sind die wichtigsten Parameter der Solarzellen die unter Variation der Temperatur bestimmt wurden aufgeführt.

Tabelle 4: Polykristalline Zelle.

	$T = 20\text{ °C}$	$T = 35\text{ °C}$	$T = 50\text{ °C}$
I_{sc} in mA	$151,0 \pm 0,3$	$149,0 \pm 0,3$	$147,0 \pm 0,3$
U_{oc} in V	$0,63 \pm 0,04$	$0,61 \pm 0,04$	$0,61 \pm 0,05$
I in mA	$108,0 \pm 0,3$	$99,0 \pm 0,3$	$96,0 \pm 0,3$
U_{MPP} in V	$0,310 \pm 0,003$	$0,320 \pm 0,003$	$0,310 \pm 0,003$
P_{MPP} in mW	$33,48 \pm 0,32$	$31,68 \pm 0,30$	$29,76 \pm 0,30$
FF in %	$35,05 \pm 2,50$	$34,8 \pm 2,5$	$33,0 \pm 2,7$

Tabelle 5: Tandemzelle.

	$T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	AM-Filter $T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
I_{sc} in mA	$7,90 \pm 0,03$	$5,420 \pm 0,003$	$0,940 \pm 0,003$
U_{oc} in V	$0,88 \pm 0,04$	$0,776 \pm 0,032$	$0,705 \pm 0,024$
I_{MPP} in mA	$6,84 \pm 0,03$	$4,240 \pm 0,003$	$0,700 \pm 0,003$
U_{MPP} in V	$0,640 \pm 0,003$	$0,600 \pm 0,003$	$0,540 \pm 0,003$
P_{MPP} in mW	$4,378 \pm 0,022$	$2,544 \pm 0,012$	$0,378 \pm 0,003$
FF in %	$63,3 \pm 2,8$	$60,5 \pm 2,5$	$57,0 \pm 2,0$

4.2.3 Diskussion

Da in Gleichung (3) I_{ph} der vertikalen Verschiebung an der Ordinate entspricht, wird erwartet, dass dieser nahe Null ist, wenn die Solarzelle nicht beleuchtet wird, also in Abb. 4 und Abb. 5.

5 Schlussfolgerung

6 Anhang

6.1 Solarzelle

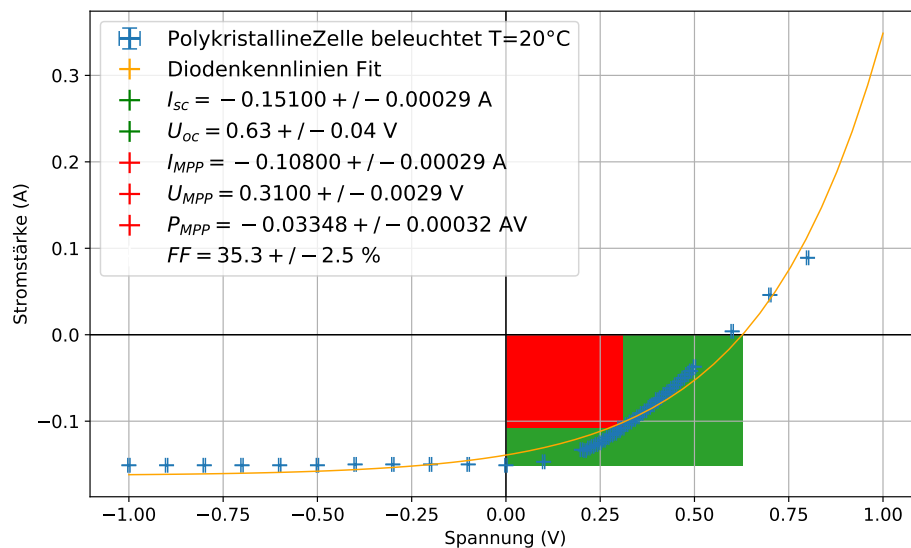


Abbildung 7: I-U-Kennlinie einer polykristallinen Silizium Solarzelle bei Raumtemperatur unter Beleuchtung.

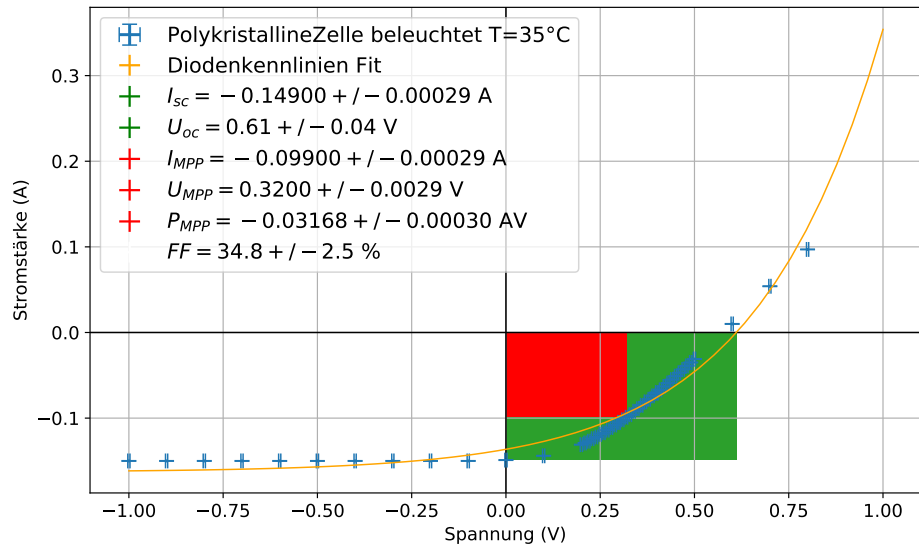


Abbildung 8: I-U-Kennlinie einer polykristallinen Silizium Solarzelle bei $T = 35^{\circ}\text{C}$ unter Beleuchtung.

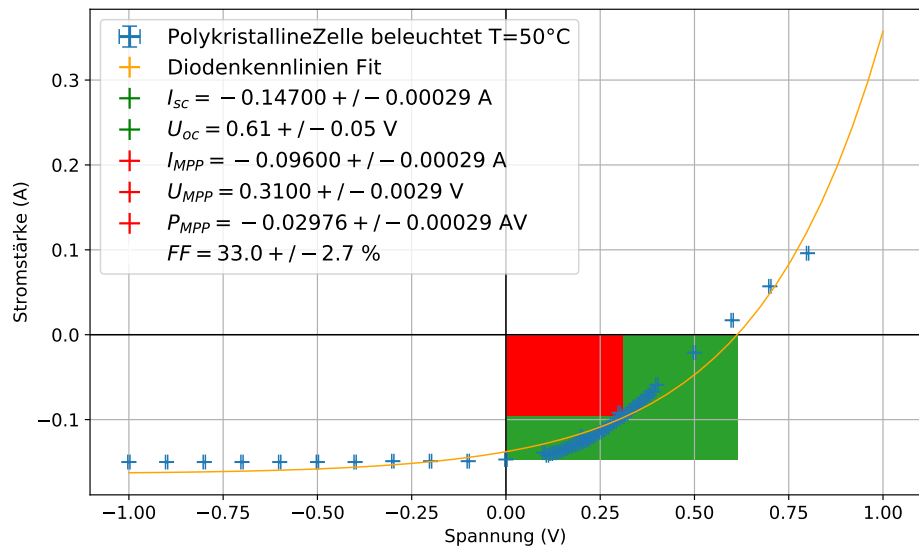


Abbildung 9: I-U-Kennlinie einer polykristallinen Silizium Solarzelle bei $T = 50^{\circ}\text{C}$ unter Beleuchtung.

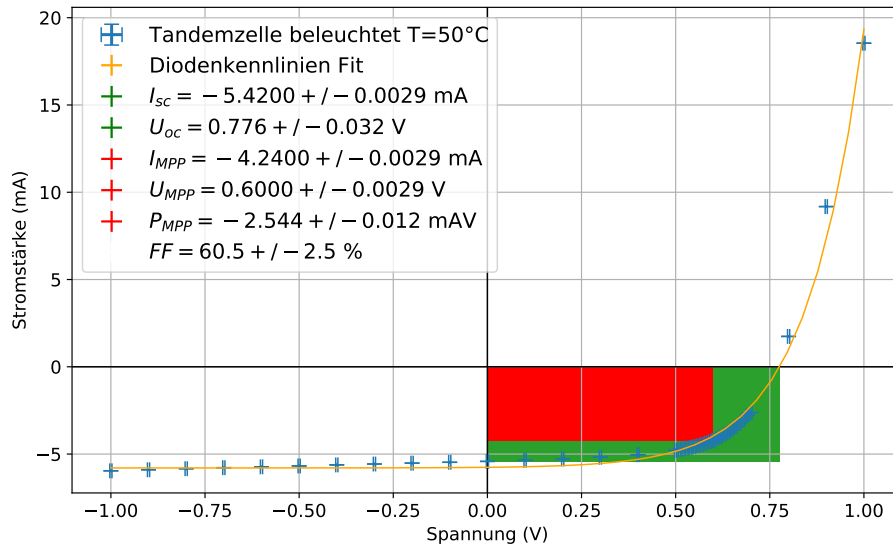


Abbildung 10: I-U-Kennlinie einer Tandemzelle bei $T = 50^{\circ}\text{C}$ unter Beleuchtung.

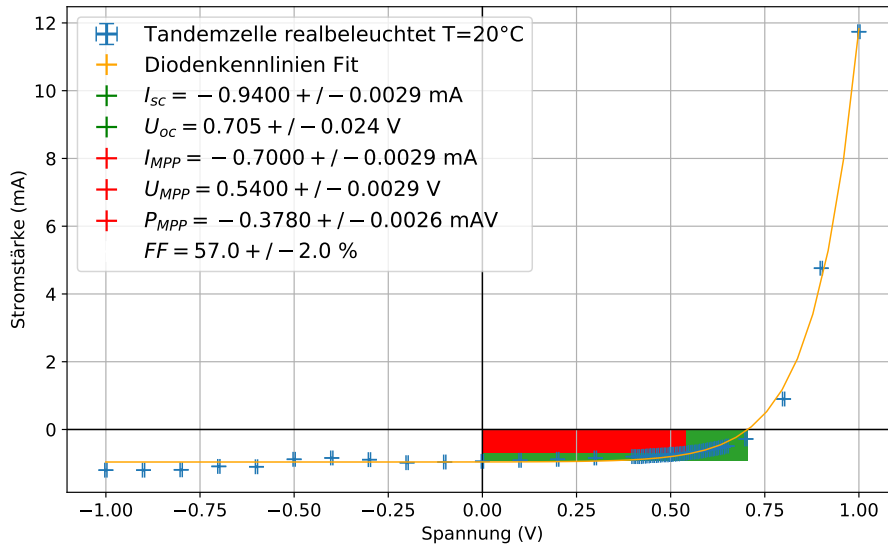


Abbildung 11: I-U-Kennlinie einer Tandemzelle bei Raumtemperatur unter Beleuchtung durch einen AM-Filter.